

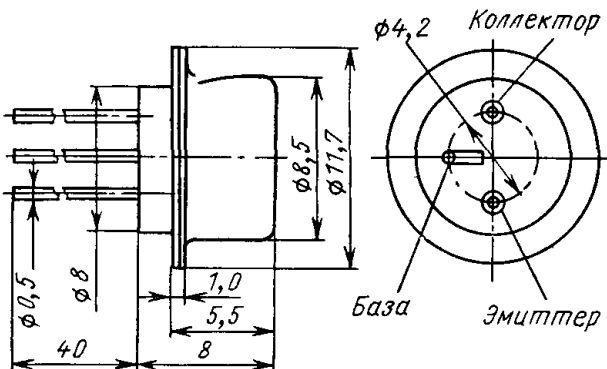
МП16, МП16А, МП16Б

Транзисторы германиевые сплавные *p-n-p* переключательные низкочастотные маломощные

Предназначены для применения в схемах переключения и формирования импульсов

Выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 1$ мА не менее

МП16, МП16А	1 МГц
МП16Б	2 МГц

Время переключения при $U_{КЭ} = 15$ В, $R_{К} = 1,5$ кОм не более

МП16	2 мкс
МП16А	1,5 мкс
МП16Б	1 мкс

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 1$ В, $I_{К} = 10$ мА.

при $T = 293$ К

МП16	20 – 35
МП16А	30 – 50
МП16Б	45 – 100

при $T = 213$ К

МП16	10 – 35
----------------	---------

МП16А	15 – 50
-----------------	---------

МП16Б	23 – 100
-----------------	----------

при $T = 343$ К.

МП16	20 – 80
----------------	---------

МП16А	30 – 100
-----------------	----------

МП16Б	45 – 200
-----------------	----------

Материал взят из источника:

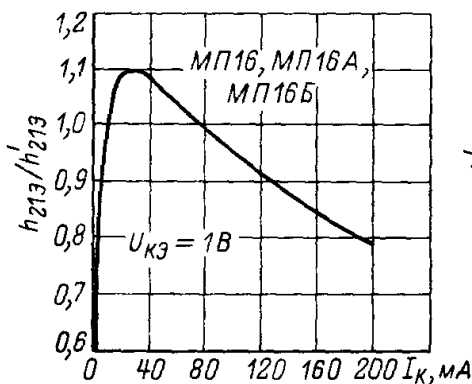
Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

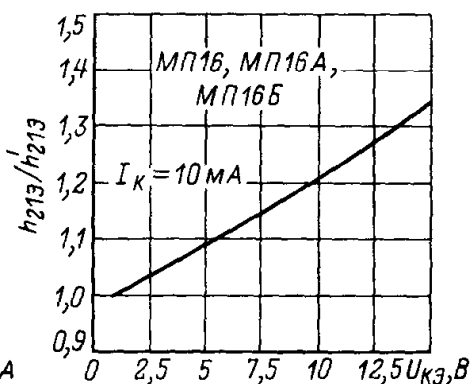
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более	0,15 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более	0,35 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 15$ В, $U_{БЭ} =$ $= 0,5$ В не более	
при $T = 293$ К	25 мкА
при $T = 343$ К	200 мкА
Импульсный обратный ток коллектор-эмиттер при 293 К, $U_{КЭ} = 12$ В, $R_K = 1,5$ кОм не более	400 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq$ ≤ 2 кОм	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	15 В
Импульсный ток коллектора	300 мА
Импульсный ток эмиттера	300 мА
Среднее значение тока эмиттера	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T = 213 - 318$ К, $p \geq 6666$ Па	200 мВт
при $T = 213 - 318$ К, $p = 665$ Па	100 мВт
при $T = 343$ К	75 мВт
Общее тепловое сопротивление *	200 К/Вт
Температура перехода	358 К
Температура окружающей среды	От 213 до 343 К

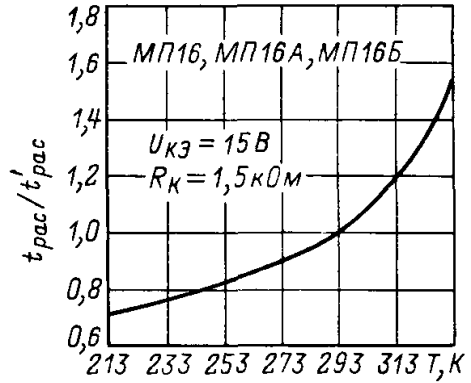
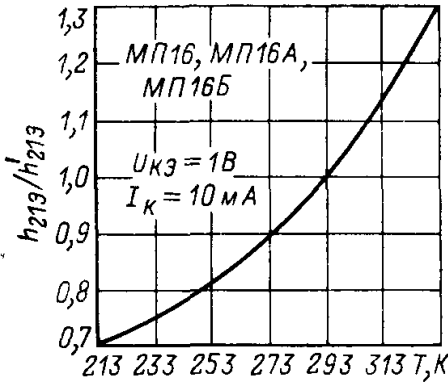


Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от тока коллектора.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от напряжения коллектор-эмиттер.

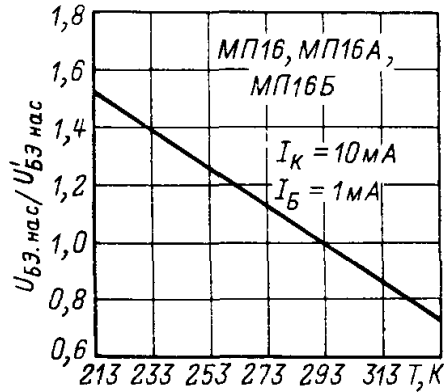
Материал взят из источника:



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от температуры.

Зависимость относительного времени рассасывания от температуры.

Зависимость относительного напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.



Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985